




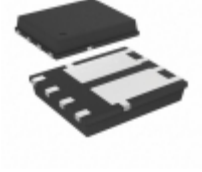



	<h2>SI7846DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7846DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7846DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6875 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7846DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6875 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 4A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7846DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7846DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7846DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7846DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7846DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7848BDP-T1 Vishay Precision Group SI7848BDP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7846DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7846DP VISHAY SI7846DP VISHAY</p>
 <p>SI7844DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7846DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7846SAC VISHAY SI7846SAC VISHAY</p>	 <p>SI7846DP-TI VISHAY SI7846DP-TI VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI7820DN-T1-GE3	SI7840BDP	SI7840BDP-T1-E3	SI7840BDP-T1-E3	SI7840BDP-T1-GE3
SI7840BDP-T1-GE3	SI7840DP	SI7840DP-T1	SI7840DP-T1-E3	SI7840DP-T1-GE3
SI7840DP-T1-GE3	SI7842DP	SI7842DP-T1-E3	SI7842DP-T1-E3	SI7842DP-T1-GE3
SI7842DP-T1-GE3	SI7844DP	SI7844DP-T1	SI7844DP-T1-E3	SI7844DP-T1-E3
SI7844DP-T1-GE3	SI7844DP-T1-GE3	SI7846DP	SI7846DP-T1-E3	SI7846DP-T1-E3
SI7846DP-T1-GE3	SI7846DP-TI	SI7846SAC	SI7848BDP-T1-E3	SI7848BDP-T1-E3
SI7848BDP-T1-GE3	SI7848BDP-T1-GE3	SI7848DP	SI7848DP-T1-E3	SI7848DP-T1-E3
SI7848DP-T1-GE3	SI7850DP	SI7850DP-T1-E3	SI7850DP-T1-E3	SI7850DP-T1-GE3
SI7850DP-T1-GE3	SI7852ADP	SI7852ADP-T1-E3	SI7852ADP-T1-E3	SI7852ADP-T1-GE3
SI7852ADP-T1-GE3	SI7852DP	SI7852DP-T1-E3	SI7852DP-T1-E3	SI7852DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited